

马农农 天津55信箱中国电子科技集团公司第四十六研究所 300192

何友琴 天津55信箱中国电子科技集团公司第四十六研究所 300192

李雨辰 天津55信箱 信息产业部电子第四十六研究所 300192

等

摘要：在砷化镓工艺过程中，很多失效问题与表面的沾污有关，二次离子质谱分析是表面分析的有力手段，本文提供一种用二次离子质谱分析检测砷化镓表面钠、钾和铝的沾污水平的测试方法。

关键词：二次离子质谱, 砷化镓抛光晶片, 金属表面沾污

文章全文为PDF格式，请下载到本机浏览。[[下载全文](#)]

如您没有PDF阅读器，请先下载PDF阅读器 Acrobat Reader [[下载阅读器](#)]

Measuring surface contaminant on polioshed GaAs wafer by  
secondary ion masss spectrometry

300192

300192

300192

Abstract: The failure problems in GaAs process are often related to surface contaminant on polioshed GaAs wafer. Secondary ion masss spectrometry is an excellent technique for measuring surface contaminant. A test method is provided for measuring surface sodium, aluminum, and potassium on polioshed GaAs wafer by secondary ion masss spectrometry in this paper.

Key words: SIMS, GaAs wafer, Surface contaminant

[【大 中 小】](#) [[关闭窗口](#)]